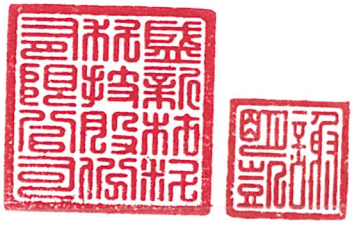
附表二

公司概況資料表

以下資料由盛新材料科技股份有限公司公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意



- **認購相關資訊**
- **公司簡介**
- **主要業務項目**
- **最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**
- **最近五年度簡明資產負債表**
- **最近三年度財務比率**

公司名稱：盛新材料科技股份有限公司 (股票代號：6930)

董事長	謝明凱
總經理	謝銘勳
資本額	900,000,000元
輔導推薦證券商	第一金證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台中銀證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	第一金證券股份有限公司 吳小姐 (02)2563-6262分機990
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購盛新材料科技股份有限公司股票之相關資訊			
證券商名稱	主辦	協辦	協辦
	第一金證券股份有限公司	永豐金證券股份有限公司	台中銀證券股份有限公司
認購日期(註)	115年6月25日	115年6月25日	115年6月25日
認購股數（股）(註)	1,400,000	100,000	100,000

修訂日期：114年12月

認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率(註)	1.56%	0.11%	0.11%
認購價格(註)	每股新臺幣35元整		
申請或登錄興櫃前三個月認購之總股數及占擬櫃檯買賣股份總數之比率（證券商認購創櫃板階段之新股且計入興櫃應認購股份者適用）	不適用		
認購價格之訂定依據及方式	(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市價法、成本法及收益法之比較。 本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場法、成本法及收益法等方式，以推算合理之認購價格，作為盛新材料科技股份有限公司(以下簡稱盛新材料或該公司)辦理股票登錄興櫃之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、未來發展、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。 基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括： 1.市場法：(1)本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及(2)股價淨值比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。 2.成本法，亦稱帳面價值法 (Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。 3.收益法，其中之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，簡稱 DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。 其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握；另考量本益比評價方法係以企業穩定且具代表性之獲利水準為基礎，方能合理反映其企業價值。由於該公司尚處於營業虧損狀態，故不適用市價法-本益比法進行評估，故本次輔導推薦證券商主要採用市場法-股價淨值比法作為評估基準。 (二)發行人與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及股價淨值比之比較情形。 盛新材料主要從事碳化矽晶體（SiC ingot）及碳化矽晶圓基板（SiC substrate）之研發、生產及相關加工服務，並同時		

具備導電型及半絕緣型碳化矽材料之量產能力，屬於半導體產業鏈上游材料供應商。碳化矽晶圓基板經由下游廠商進行外延成長（Epitaxy）及半導體製程後，可製造各類碳化矽功率元件或射頻元件，例如：

•碳化矽功率 MOSFET

•碳化矽肖特基二極體（SBD）

•射頻功率元件（RF device）

其應用領域涵蓋電動車電力系統、充電設備、再生能源系統、工業電源設備、5G 通訊設備及航太雷達等多元產業。經檢視相關產業及同業資料，目前國內上市及上櫃公司中並無與該公司產品完全相同之同業，並綜合考量產業屬性、產品類型及應用領域等因素後，選擇同業如下：

1.漢磊科技股份有限公司(以下簡稱漢磊，上櫃公司，股票代號3707)：主要業務為矽磊晶片、埋藏層磊晶片、多層矽磊晶片、矽磊晶於 Silicon on Insulator 上(SOI)、GaN 磊晶片、SiC 磊晶片等產品之製造，應用於高功率場效電晶體(PowerMOSFET)、二極體(Diodes)、絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、電源管理 IC(PMIC)等功率元件之生產。

2.嘉晶電子股份有限公司(以下簡稱嘉晶，上市公司，股票代號3016)：主要從事矽磊晶、碳化矽磊晶和氮化鎵磊晶之生產及代工，適合於通訊、軍用、太空、高速高壓高電流功率等應用領域。

3.環球晶圓股份有限公司(以下簡稱環球晶，上櫃公司，股票代號6488)：主要從事半導體材料之製造及銷售等業務，其產品主要為半導體晶棒及客製化之半導體晶圓，並投入化合物半導體產品開發，具備碳化矽長晶爐自製與熱場設計能力，產品包括4吋~8吋導電型碳化矽晶圓、4吋~8吋半絕緣碳化矽晶體與晶片等。

以下茲採市場法-股價淨值比法進行評估，彙總各採樣同業漢磊(3707)、嘉晶(3016)及環球晶(6488)、上市(櫃)半導體股115年6月份至115年8月份之平均股價淨值比列示如下：

單位:倍

項目	115年6月	115年7月	115年8月	平均
漢磊(3707)	4.79	2.89	2.87	3.52
嘉晶(3016)	7.87	4.71	5.74	6.11
環球晶(6488)	5.15	4.38	4.51	4.68
上櫃半導體類	6.94	5.51	5.70	6.05
上市半導體類	9.86	9.25	8.62	9.24

資料來源：證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料。

依上表所示，該公司採樣同業及上市櫃股票-半導體類最近三個月(115年6月~115年8月)之平均股價淨值比區間為3.52~9.24倍，依上述股價淨值比區間為參考依據，並排除極端值為上市半導體類平均股價淨值比9.24後，其股價淨值比區間為3.52~6.11倍。該公司115年上半年度經會計師核閱之財務報告權益總額為795,849仟元，以目前已發行股份90,000仟股，計算每股淨值為8.84元，並以此每股淨值為計算基礎

	推算之股價淨值比參考價格區間為31.11~54.01元，故本次認購價格為每股新臺幣35元，尚屬合理。 (三) 所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明專家意見或鑑價報告內容及結論。 本次所議定之認購價格並未參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告。 (四) 推薦證券商就其與發行人所共同議定承銷價格合理性之評估意見。 綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，參酌該公司所處產業前景、經營績效、發行市場環境、同業之市場狀況及興櫃市場流通性風險等因素後，由推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為35元，尚屬合理。

註：輔導推薦證券商認購公司登錄創櫃板期間發行之新股，且計入其於興櫃應認購股份者，應依序敘明每次認購日期及其認購股數、認購價格。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

盛新材料科技股份有限公司成立於民國109年6月，主要從事第三類半導體碳化矽（SiC）晶錠及基板之研發、製造與銷售，產品涵蓋導電型及半絕緣型碳化矽晶錠與基板，擁有碳化矽長晶、晶種、晶體品質控制及電性調控等核心技術。公司致力於發展大尺寸碳化矽材料，產品應用涵蓋功率半導體、高頻通訊及電力電子等領域，並積極布局電動車、5G、人工智慧（AI）資料中心、高效能運算及衛星通訊等高成長市場。未來將持續深化碳化矽材料技術及量產能力，推進8吋及12吋大尺寸基板產品與產能建置，透過技術自主、產品升級及客戶拓展，打造具國際競爭力之碳化矽材料供應商，掌握第三類半導體產業高速成長契機。

二、公司沿革

年度	重要記事
109 年度	**公司成立，啟動 SiC 技術布局**
	• 盛新材料成立，實收資本額新台幣 10,000,000 元。
	• 建置 10 台量產長晶爐，長晶爐共 15 台並啟動 4 吋 SI-SiC 晶圓小量生產及送樣測試。
	• 產出國內首片 6 吋 SI-SiC 晶圓。
	• 取得中科院碳化矽長晶相關專利 14 項。
	• 完成現金增資新台幣 20,000,000 元，實收資本額達新台幣 30,000,000 元。
110 年度	**6 吋 N 型 SiC 製程技術突破**
	• 啟動 6 吋 N-SiC 製程開發。
	• 完成 6 吋 N-SiC 晶錠製程驗證。
	• 完成現金增資新台幣 400,000,000 元，實收資本額達新台幣 430,000,000 元
111 年度	**6 吋量產、8 吋技術突破，策略股東加入，進入資本市場**
	• 6 吋 N-SiC 晶錠進入量產並展開國內外送樣測試。
	• 產出國內首顆 8 吋 SiC 晶錠及晶圓。
	• 建立 6 吋 N-SiC P+晶錠自製設備量產能力。

修訂日期：114年12月

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)	
	• 啟動 8 吋 SiC 長晶及晶圓加工技術開發。
	• 完成現金增資新台幣 70,000,000 元，實收資本額達 500,000,000 元，同時引進鴻海、全新、華稻、中美鑫等策略性股東。
	• 取得經濟部工業局「8 吋半絕緣型碳化矽長晶設備開發及關鍵材料驗證」計畫核准，建立大尺寸 SI-SiC 長晶技術與設備自主化能力。
	• 股票公開發行核准，取得股票代號 6930，正式進入資本市場。
112 年度	**產品驗證深化及量產能力持續擴大**
	• 6 吋 N-SiC P+晶錠、6 吋 SI-SiC 晶圓持續展開國內外送樣測試。
	• 6 吋 N-SiC P+晶錠自製設備量產。
	• 持續推進 8 吋 SiC 長晶及晶圓加工技術。
	• 取得南科橋頭園區租地資格。
113 年度	**8 吋 SI-SiC 突破，建立國內領先產能**
	• 產出國內首片 8 吋 SI-SiC 晶片。
	• 6 吋 N-SiC P+及 6 吋 SI-SiC 產品持續拓展國內外市場送樣驗證。
	• 8 吋 N-SiC P+晶錠進入自製設備量產。
	• 推進 8 吋 N-SiC P 規晶錠量產製程開發。
	• 建置國內規模領先之 8 吋長晶爐產能，共 65 台。
	• 取得 IATF 16949 符合性證明，建立車用半導體材料品質管理體系，布局汽車電子及車用 SiC 供應鏈。
114 年度	**8 吋產品進入量產，切入高階應用市場**
	• 8 吋 N-SiC P 規晶錠於下半年進入量產階段。
	• 8 吋 SiC 晶圓持續進行日本市場送樣測試。
	• 完成現金增資新台幣 200,000,000 元，實收資本額達新台幣 700,000,000 元。
	• 啟動高階 AI 封裝關鍵材料開發。
115 年度	**12 吋 SiC 技術突破，布局 AI 先進封裝**
	• 產出國內首顆以國產長晶設備生長之 12 吋 SiC 晶球。
	• 通過經濟部 A+企業創新研發淬鍊計畫「12 吋碳化矽單晶長晶技術及材料驗證開發計畫」，推動 12 吋 SiC 單晶長晶技術及材料驗證。
	• 國內首片 P-type SiC 晶圓亮相，拓展高階功率半導體、車用及 AI 電源等應用。
	• 完成現金增資新台幣 200,000,000 元，實收資本額達新台幣 900,000,000 元。
	• 持續布局 AI 先進封裝及高階 SiC 材料應用。

三、經營理念

盛新材料科技秉持「技術自主、品質卓越、客戶共創、永續發展」之經營理念，專注於碳化矽（SiC）材料及相關產品之研發與製造，持續強化材料、製程及設備之自主技術，提升產品品質與市場競爭力。因應電動車、綠色能源、AI 及高效能運算等市場需求，持續深化產品開發與客戶合作，提供高品質、高可靠度之碳化矽產品，創造公司、客戶及股東之長期價值。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

四、未來展望

隨著 AI 伺服器、高效能運算（HPC）、電動車、再生能源及儲能等高功率應用快速發展，對高效率、高耐壓及低功率損耗之碳化矽（SiC）半導體材料需求持續增加。隨著 SiC 晶圓尺寸朝 8 吋及更大尺寸發展，對高品質晶體長晶、晶圓製造及材料良率之要求亦持續提升。

本公司將持續投入碳化矽長晶及晶圓製造技術研發，提升晶體品質、良率及產能，並積極布局車用、AI 資料中心、綠能及高功率電源等應用市場，強化產品競爭力與客戶合作關係。未來將持續擴充碳化矽材料產品布局，提升供應能力及市場滲透率，朝成為具國際競爭力之碳化矽關鍵材料供應商穩健邁進。

TOP

主要業務項目：

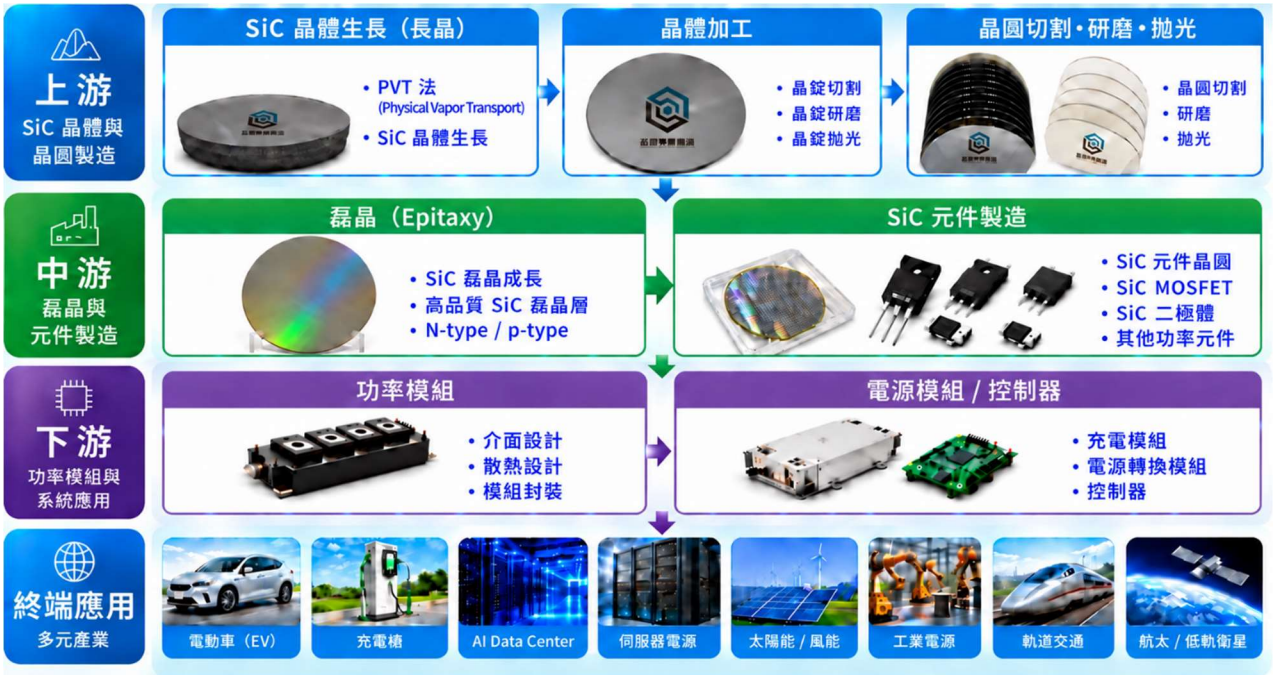
主要從事碳化矽（SiC）半導體材料之研發、長晶、晶錠加工及晶圓製造與銷售。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

碳化矽（SiC）為第三類半導體材料，具有高耐壓、耐高溫及低功率損耗等特性，主要應用於電動車、充電樁、再生能源、儲能、AI 資料中心及工業電源等高功率電子領域。

碳化矽產業鏈上游主要為高純度矽原料及晶體生長與加工、晶圓製造，包括原料、SiC 長晶、晶錠、切割、研磨及拋光等製程；中游為外延與晶圓檢測；下游則為 SiC 功率元件、功率模組及終端應用。

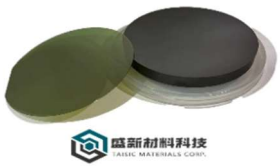
本公司主要從事碳化矽長晶、晶錠加工及晶圓製造之材料開發與銷售，位於碳化矽產業鏈之關鍵材料環節。



修訂日期：114年12月

主要業務項目：

主要從事碳化矽（SiC）半導體材料之研發、長晶、晶錠加工及晶圓製造與銷售。

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
碳化矽產品		導電型 SiC 材料： 低電阻率、高耐壓、低功率損耗，適合電能轉換與高功率傳輸。 半絕緣型 SiC 材料： 高電阻率、低介電損耗、高頻及高功率傳輸特性。	21,841	64.45
勞務收入	碳化矽材料檢測與認證	材料純度成分分析、晶體缺陷檢測、晶圓尺寸與表面檢測、電性與可靠度驗證等。	12,045	35.55
合　計			33,886	100.00

TOP

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	110年(重編)	111年	112年	113年	114年	115年截至8月份止 **(自結數)(註2)**
營業收入	3,872	3,685	12,142	31,748	33,886	49,365
營業毛利	(45,799)	(34,229)	(39,992)	(41,926)	(116,043)	(75,505)
毛利率(%)	(1,182.83)	(928.87)	(329.37)	(132.06)	(342.45)	(152.95)
營業損益	(171,549)	(297,780)	(322,308)	(306,444)	(280,378)	(182,513)
營業外收入	561	13,433	16,261	13,774	8,128	3,126
營業外支出	(5,766)	(11,292)	(2,780)	(12,118)	(17,769)	(11,151)
稅前損益	(176,754)	(295,639)	(308,827)	(304,788)	(290,019)	(190,539)
稅後損益	(176,807)	(295,573)	(308,827)	(304,788)	(290,042)	(190,563)
每股盈餘（元）	(6.43)	(6.40)	(6.18)	(6.10)	(4.36)	(2.53)
發放 現金股利(元)	—	—	—	—	—	—
發放 股票股利(資本公積轉增資)(元)	—	—	—	—	—	—
發放 股票股利(盈餘轉增資)(元)	—	—	—	—	—	—

註1：110~114年度財務資料係經會計師查核簽證。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

修訂日期：114年12月

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度		110年(重編)	111年	112年	113年	114年
流動資產		89,181	304,896	209,726	196,136	265,341
基金及長期投資		—	—	—	—	—
固定資產		335,010	297,925	396,783	639,730	542,708
無形資產		15,258	942	1,106	789	1,093
其他資產		65,366	187,690	173,596	39,117	84,864
資產總額		504,815	791,453	781,211	875,772	894,006
流動負債	分配前	177,652	105,048	401,084	811,587	596,439
	分配後	177,652	105,048	401,084	811,587	596,439
長期負債		93,261	48,076	50,625	39,471	61,733
其他負債		—	—	—	—	—
負債總額	分配前	270,913	153,124	451,709	851,058	658,172
	分配後	270,913	153,124	451,709	851,058	658,172
股本		430,000	500,000	500,000	500,000	700,000
資本公積		3,780	633,780	138,329	—	301,162
保留盈餘	分配前	(199,878)	(495,451)	(308,827)	(475,286)	(765,328)
	分配後	(199,878)	(495,451)	(308,827)	(475,286)	(765,328)
長期股權投資未實現跌價損失		—	—	—	—	—
累積換算調整數		—	—	—	—	—
股東權益總額	分配前	233,902	638,329	329,502	24,714	235,834
	分配後	233,902	638,329	329,502	24,714	235,834

TOP

最近三年度財務比率

項目 \ 年度		112年	113年	114年
財務比率	毛利率(%)	(329.37)	(132.06)	(342.45)
	流動比率(%)	52.29	24.17	44.49
	應收帳款天數(天)	15	31	48
	存貨週轉天數(天)	189	115	65
	負債比率(%)	57.82	97.18	73.62

TOP

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!

修訂日期：114年12月